

性能特点

类型: SPDT 吸收式
频率范围: DC-4 GHz
插入损耗: 0.6 dB
隔离度: 60 dB
集成逻辑控制

芯片尺寸: 1.25x1.00x0.1 mm

• 100%在片测试

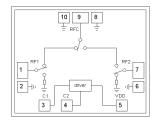
产品介绍

ZXA4201 是一款FET单刀双掷(SPDT)吸收式微波开关芯片(Die)。频率范围覆盖 DC~4GHz,插入损耗 0.6dB,隔离度60dB,开关速度30ns,采用0/+5V逻辑控制。该芯片主要应用于微波系统中,实现信号通道开通和关断的功能。芯片采用了片上通孔金属化工艺,保证了良好的接地;芯片背面进行了金属化处理,适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

电气性能参数 (TA = +25℃)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC		4	GHz
插入损耗		0.6		dB
隔离度		60		dB
回波损耗(开态)		18		dB
回波损耗(关态)		18		dB
开关速度		30		ns

功能原理图



使用限制参数

项目	数值	
工作温度	-55 ~ +85 ℃	
储存温度	-65 ~ +150 ℃	

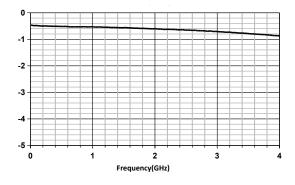
*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏



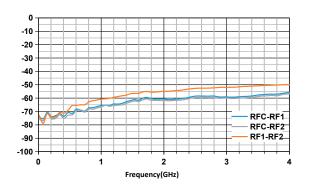
该产品对静电较敏感 使用中请注意防静电

典型测试曲线

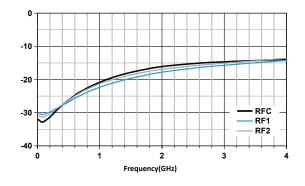
插入损耗 VS 频率



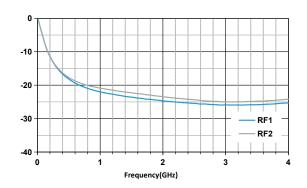
隔离度 VS 频率



回波损耗(开态) VS 频率



回波损耗(关态) VS 频率



四川中科微芯电子有限公司 SiChuan ZhongKe Microelectronics Co., Ltd.

网址: https://www.zkmc.com

地址:成都金牛区兴科中路36号3-4F

电话: 028-6815 2988 E-mail: info@zkmc.cn 传真: 028-6815 2988

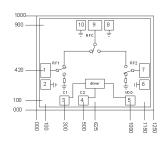
返回上一级目录





键合点定义

管脚	名称
1	RFI
3	Cl
4	C2
5	VDD
7	RF2
9	RFC
其他	GND



说明

1. RF PAD:100um*150um 2. DC PAD:100um*100um

偏置电压&电流(VDD)

VDD 范围=+5Vdc±10%		
VDD(Vdc)	IDD(Typ.)(mA)	
+5	5	

控制电压(CTRL)

控制	偏置条件	
0	0∼+0.8Vdc at 0 uA Typ.	
1	+4.0~+5Vdc at 150 uA Typ.	

真值表

控制输入		信号路径状态
Cl	C2	信与始任从心
1	0	RFC-RF1
0	1	RFC-RF2
0	0	隔离

注: 射频端口需隔直电容

地址:成都金牛区兴科中路36号3-4F

传真: 028-6815 2988